

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3891988号
(P3891988)

(45) 発行日 平成19年3月14日(2007.3.14)

(24) 登録日 平成18年12月15日(2006.12.15)

(51) Int.C1.

F 1

G02F	1/1368	(2006.01)	G02F	1/1368	
G02F	1/1343	(2006.01)	G02F	1/1343	
G02F	1/1345	(2006.01)	G02F	1/1345	
HO1L	21/28	(2006.01)	HO1L	21/28	301R
HO1L	21/3205	(2006.01)	HO1L	21/88	R

請求項の数 10 (全 13 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2004-532 (P2004-532)
(22) 出願日	平成16年1月5日(2004.1.5)
(62) 分割の表示	特願平8-314620の分割
原出願日	平成8年11月26日(1996.11.26)
(65) 公開番号	特開2004-157555 (P2004-157555A)
(43) 公開日	平成16年6月3日(2004.6.3)
審査請求日	平成16年1月5日(2004.1.5)
審判番号	不服2005-22435 (P2005-22435/J1)
審判請求日	平成17年11月21日(2005.11.21)
(31) 優先権主張番号	1995 P 62170
(32) 優先日	平成7年12月28日(1995.12.28)
(33) 優先権主張国	韓国(KR)
(31) 優先権主張番号	1996 P 18516
(32) 優先日	平成8年5月29日(1996.5.29)
(33) 優先権主張国	韓国(KR)

(73) 特許権者	390019839
三星電子株式会社	Samsung Electronics Co., Ltd.
大韓民国京畿道水原市靈通区梅灘洞416	
(74) 代理人	100093779
弁理士 服部 雅紀	
(72) 発明者	權 寧贊
大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣島洞5	
O番地示範アパート19棟96号	
合議体	
審判長	向後 晋一
審判官	井上 博之
審判官	西村 直史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法およびTFT基板

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

1次写真蝕刻工程を用いて、TFT部及びゲート-パッド連結部の基板上に耐火性金属で形成した第1金属膜及びアルミニウム又はアルミニウム合金で形成した第2金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階であって、テーパ状の前記第1金属膜に対してテーパ状の前記第2金属膜が段差なく積層されてなる前記ゲート電極を形成する段階と、

前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、

2次写真工程を用いて前記TFT部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、

3次写真工程を用いて前記TFT部に第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成し、パッド部に第3金属膜よりなるパッド電極を形成する段階と、

前記ソース電極及び前記ドレイン電極並びに前記パッド電極が形成された前記基板の全面に保護膜を形成した後、前記保護膜及び前記絶縁膜を4次写真蝕刻して前記TFT部の前記ドレイン電極と前記ゲート-パッド連結部の前記ゲートパッドと前記パッド部の前記パッド電極の一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、

前記保護膜パターンをマスクとして前記第2金属膜を蝕刻して前記ゲート-パッド連結部の前記第1金属膜を露出させる段階と、

5次写真工程を用いて前記TFT部の前記ドレイン電極と接触する第1画素電極パター

10

20

ンと、前記ゲート - パッド連結部の前記第1金属膜及び前記パッド部の前記パッド電極と接觸する第2画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】

前記第1金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】

前記第3金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】

前記1次写真蝕刻工程で第2金属膜に対してテープ蝕刻を行い、引続き第1金属膜に対して蝕刻を行うことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】

前記絶縁膜はSiNx及びSiNxとSiOxとの二重膜よりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】

基板上に形成されたテープ状の第1金属膜と、前記第1金属膜上に段差なく形成されたテープ状の第2金属膜よりなるTFT部のゲート電極と、

前記基板上に形成された第1金属膜と、前記第1金属膜上的一部分に形成された第2金属膜よりなるゲート - パッド連結部のゲートパッドと、

前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された前記基板上に、前記ゲートパッドの前記第1金属膜の一部を露出させるように形成された絶縁膜と、

前記ゲート電極上の前記絶縁膜上に形成された半導体膜パターンと、

前記半導体膜パターン上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、

前記絶縁膜上に形成されたパッド部のパッド電極と、

前記ドレイン電極を露出させるコンタクトホールと前記ゲートパッドの前記第1金属膜を露出させるコンタクトホールと前記パッド電極を露出させるコンタクトホールとを持つように形成された保護膜パターンと、

前記保護膜パターン上に形成され、前記ドレイン電極と接觸する第1画素電極パターンと、

前記保護膜パターン上に形成され、前記ゲートパッドの前記第1金属膜及び前記パッド電極と接觸する第2画素電極パターンとを具備し、

前記第1金属膜は耐火性金属で形成され、前記第2金属膜はアルミニウム又はアルミニウム合金で形成されることを特徴とするTFT基板。

【請求項7】

前記第1金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つよりなることを特徴とする請求項6に記載のTFT基板。

【請求項8】

前記絶縁膜は窒化膜SiNxよりなることを特徴とする請求項6に記載のTFT基板。

【請求項9】

前記第1画素電極パターン及び前記第2画素電極パターンはITOよりなることを特徴とする請求項6に記載のTFT基板。

【請求項10】

前記保護膜パターンの一部は前記半導体膜パターンと直接接觸することを特徴とする請求項6に記載のTFT基板。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示装置の製造方法に係り、特に能動素子として薄膜トランジスタを具備して写真工程の数が減らすことのできる液晶表示装置の製造方法に関する。

10

20

30

40

50

【背景技術】**【0002】**

情報表示装置は電気的な信号を視覚映像に変換させ、人間が直接情報を解読可能にする電子システムの一種であって、電子光学的素子である。このような表示装置としては液晶表示装置（Liquid Crystal Display：LCD）が最も広く使用されており、その他にもプラズマ放電を用いるプラズマ表示装置（Plasma Display Panel：PDP）、エレクトロルミネンス（Electro Luminescence：EL）、最近多く研究されている電界放出表示装置（Field Emission Display：FED）、そして反射形としてミラーの動きを制御する可変ミラー素子（Deformable Mirror Device：DMD）等が開発され急速に普及している。

【0003】

10

その中で、液晶表示装置は電場により分子の配列が変化する液晶の光学的性質を用いる液晶技術と、微細パターンを形成することができる半導体技術とを合わせた表示装置であって平板表示装置の代名詞と言われる。液晶表示装置の中の、薄膜トランジスタを能動素子として使用する薄膜トランジスタ液晶表示装置（Thin Film Transistor LCD：TFT-LCD）は低消費電力、低電圧駆動力、薄形、軽量等の多様な長所を有している。

【0004】

20

一方、薄膜トランジスタ（以下TFTと称する）は一般トランジスタに比べて非常に薄いので、この製造工程は一般トランジスタの製造工程より複雑で生産性が低く、製造コストも高い。特に製造段階毎にマスクが使用され少なくとも7枚のマスクが必要である。従って、TFTの生産性を高め、製造コストを低めるための様々な方法が研究されており、特に製造工程に使用されるマスクの数を減らすための方法が広く研究されている。

【0005】

以下、添付した図面に基づき従来の技術による液晶表示装置の製造方法を説明する。

図1乃至図4は従来の技術による液晶表示装置の製造方法を説明するため示した断面図であって、特許文献1を参照したものである。各図で部材符号AはTFT部を示し、Bはゲート・パッド連結部を示す。

【0006】

30

図1を参照すれば、透明な基板2上に純粋アルミニウムを使用して第1金属膜を形成した後、前記第1金属膜を1次写真蝕刻してゲートパターン4、4aを形成する。前記ゲートパターンはTFT部ではゲート電極4として、ゲート・パッド連結部ではゲートパッド4aとして使用される。

図2を参照すれば、通常の写真工程を行ってゲート・パッド連結部の一部領域を遮断するフォトレジストパターン（図示せず）を形成した後、前記フォトレジストパターンを酸化防止膜にて使用して前記第1金属膜を酸化させ陽極酸化膜6を形成する。この際、前記陽極酸化膜6はTFT部に形成されたゲート電極4の全面と、ゲート・パッド連結部に位置するゲートパッド4aの一部領域上に形成される。

【0007】

40

図3を参照すれば、陽極酸化膜6が形成された前記基板2の全面に、例えば窒化膜を蒸着して絶縁膜8を形成する。次いで、絶縁膜8が形成された基板2の全面に非晶質のシリコン膜12を連続的に蒸着して半導体膜を形成した後、前記半導体膜を3次写真蝕刻してTFT部に活性領域として使用される半導体膜パターン10、12を形成する。

【0008】

図4を参照すれば、半導体膜パターンが形成された基板2の全面に4次写真工程を行つてゲート・パッド連結部に形成されたゲートパッド4aの一部を露出させるフォトレジストパターン（図示せず）を形成する。次いで、前記フォトレジストパターンをマスクとして使用して前記絶縁膜8を蝕刻することによりゲートパッド4aの一部を露出させるコンタクトホールを形成する。

【0009】

50

引続き、コンタクトホールが形成された基板の全面に、例えばクロム（Cr）を蒸着した後、前記クロム膜を5次写真蝕刻してTFT部にはソース電極14a及びドレイン電極

14 b を形成し、ゲート - パッド連結部には前記コンタクトホールを通して前記ゲートパッド 4 a と連結されるパッド電極 14 c を形成する。この際、前記 5 次写真蝕刻工程の進行時、TFT 部に形成された前記ゲート電極 4 の上部の不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 12 も一部蝕刻され、ゲート電極の上部の非晶質シリコン膜 10 の一部が露出される。

【0010】

図 5 を参照すれば、ソース電極 14 a、ドレイン電極 14 b 及びパッド電極 14 c が形成された基板 2 の全面に、例えば酸化膜を蒸着して保護膜 16 を形成した後、前記保護膜を 6 次に写真蝕刻して TFT 部のドレイン電極 14 b の一部とゲート - パッド連結部のパッド電極 14 c の一部を露出させるコンタクトホールを形成する。

10

【0011】

次いで、コンタクトホールの形成された基板の全面に透明導電物質である ITO (Indium Tin Oxide) を蒸着した後、ITO 膜を 7 次写真蝕刻することにより画素電極 18、18 a を形成する。これにより、TFT ではドレイン電極 14 b と画素電極 18 が連結され、ゲート - パッド連結部ではパッド電極 14 c と画素電極 18 a が連結される。

【0012】

【特許文献 1】米国特許第 5,054,887 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0013】

20

前述した従来の液晶表示装置の製造方法によれば、ゲートラインの低抵抗化のためゲート電極の物質として純粋アルミニウムを使用した。従って、アルミニウムによるヒロック (hillock) を防止するため陽極酸化工程が伴うので、複雑な工程、生産性の減少及び製造コストの上昇の原因となった。

【0014】

本発明の目的は写真工程の数を減らして製造費用の減少及び生産性を向上させうる液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0015】

前記目的を達成するための本発明の液晶表示装置の製造方法は、1 次写真工程を用いて TFT 部及びゲート - パッド連結部の基板上に第 1 金属膜及び第 2 金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階と、ゲート電極及びゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、2 次写真工程を用いて TFT 部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、3 次写真工程を用いて TFT 部に第 3 金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成し、パッド部に第 3 金属膜よりなるパッド電極を形成する段階と、4 次写真工程を用いて前記ドレイン電極の一部、ゲートパッドの一部及びパッド電極の一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、前記保護膜パターンをマスクとして前記ゲートパッドを構成する第 2 金属膜を蝕刻して第 1 金属膜を露出させる段階と、5 次写真工程を用いて前記 TFT 部のドレイン電極と連結される第 1 画素電極パターンと、前記ゲート - パッド連結部のゲートパッドとパッド部のパッド電極を連結する第 2 画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする。

30

【0016】

前記第 1 金属膜は耐火性金属として、Cr、Ta、Mo 及び Ti よりなるグループから選択された何れか 1 つで形成し、前記 2 金属膜はアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成することが望ましい。

前記第 3 金属膜は Cr、Ta、Mo 及び Ti よりなるグループから選択された何れか 1 つで形成することが望ましい。

【0017】

前記 1 次写真工程で第 2 金属膜に対してテーパ蝕刻を行い、引続き第 1 金属膜に対して蝕刻を行うことにより、第 1 金属膜の幅を第 2 金属膜の幅より大きく形成することができ

40

50

る。

前記目的を達成するための本発明による液晶表示装置の他の製造方法は、1次写真蝕刻工程を用いてTFT部及びパッド部の基板上に、第1金属膜及び第2金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階と、ゲート電極及びゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、2次写真工程を用いてTFT部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、3次写真工程を用いてTFT部に第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成する段階と、ソース電極及びドレイン電極が形成された基板の全面に保護膜を形成した後、前記保護膜及び絶縁膜を4次写真蝕刻して前記TFT部のドレイン電極と前記パッド部のゲートパッドの一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、前記保護膜パターンをマスクとして前記第2金属膜を蝕刻してパッド部の第1金属膜を露出させる段階と、5次写真工程を用いて前記TFT部のドレイン電極と接触する第1画素電極パターンと、前記パッドの第1金属膜と接触する第2画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする。
10

【0018】

前記第1金属膜は耐火性金属として、Cr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成し、前記第2金属膜はアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成することが望ましい。

前記第3金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成し、前記絶縁膜はSi_N_x及びSi_N_xとSi_O_xとの二重膜よりなるグループから選択された何れか1つで形成することが望ましい。
20

【0019】

そして、前記1次写真蝕刻工程で第2金属膜に対してテープ蝕刻を行い、引続き第1金属膜に対して蝕刻を行う。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

以下、添付された図面に基づき本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。

図6は本発明による液晶表示装置を製造するための概略レイアウト図である。

部材番号100はゲートラインを形成するためのマスクパターンを、105はゲートパッドを形成するためのマスクパターンを、110はデータラインを形成するためのマスクパターンを、120は半導体膜を形成するためのマスクパターンを、130はソース電極／ドレイン電極を形成するためのマスクパターンを、140はTFT部の画素電極とドレイン電極を連結するコントラクトホールを形成するためのマスクパターンを、145はパッド部のゲートパッドと画素電極を連結するコントラクトホールを形成するためのマスクパターンを、150はTFT部の画素電極を形成するためのマスクパターンを、155はパッド部の画素電極を形成するためのマスクパターンを各々示す。
30

【0021】

図6を参照すれば、ゲートライン100が横に配列され、前記ゲートラインと直角方向にデータライン110がマトリックス状に配列され、前記ゲートライン100の末端にはゲートパッド105が、前記データラインの末端にはデータパッド115が備えられている。前記相互隣接した2つのゲートラインとデータラインに境界される領域に各々マトリックス状に画素領域が配列される。各TFTのゲート電極は各ゲートラインから画素領域内に突出された形で形成され、各TFTのドレイン電極とゲート電極との間に半導体膜120が形成され、TFTのソース電極は前記データライン110から突出された形で形成され、透明なITOで構成される画素電極150が各画素領域内に形成される。
40

【0022】

図7乃至図12は本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。部材符号CはTFT部であって図6のI-I'線の断面図であり、D及びEはゲート-パッド連結部及びパッド部であって図6のII-II'の断面図である。

図7はゲート電極を形成する段階を示す。

【0023】

10

20

30

40

50

詳しくは、透明な基板30上にCrのような耐火性金属を300～4000ほどの厚さで蒸着して第1金属膜31を形成した後、前記第1金属膜上にアルミニウムまたはアルミニウム合金を1000～4000ほどの厚さで蒸着して第2金属膜33を形成する。前記第1金属膜31はCr以外にTa、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つを使用して形成することができる。そして、前記アルミニウム合金としてはアルミニウム-ネオジム(Al-Nd)、アルミニウム-タンタル(Al-Ta)を使用することができる。

【0024】

次いで、前記第2金属膜33及び第1金属膜31を1次写真蝕刻してTFT部及びゲート-パッド連結部にゲート電極を形成する。この際、前記1次写真蝕刻工程は第2金属膜33に対してテーパ蝕刻を行い、連続して第1金属膜31を蝕刻することにより成される。従って、第1金属膜31の幅が第2金属膜33の幅より大きく形成される。

【0025】

このようにアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜の下部に耐火性金属膜を形成することにより、アルミニウムまたはアルミニウム合金膜と基板との間の熱膨張率の差に因したアルミニウムヒロックの発生を防止することができる。また、既存の蝕刻工程をそのまま適用すると共にアルミニウムまたはアルミニウム合金膜と耐火性金属膜との蝕刻率の差を用いてテーパ蝕刻ができる。従って、ゲート電極の形成後、後続物質の蒸着時に段差を良好にすることができる。

【0026】

図8は半導体膜パターンを形成する段階を示す。

詳しくは、ゲート電極が形成された前記基板30の全面に、例えば窒化膜または酸化膜を蒸着して絶縁膜35を形成する。次いで、絶縁膜が形成された前記基板30の全面に非晶質シリコン膜37及び不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜39を順次に蒸着して半導体膜を形成した。次いで、前記半導体膜を2次写真蝕刻してTFT部に非晶質シリコン膜37及び不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜39よりなる半導体膜パターンを形成する。

【0027】

前記絶縁膜35は2000～9000ほどの厚さ、前記非晶質シリコン膜37は1000～4000ほどの厚さ、そして前記不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜39は300～1000ほどの厚さで形成する。

図9はソース電極、ドレイン電極及びパッド電極を形成する段階を示す。

詳しくは、半導体膜パターンが形成された基板の全面にCrのような耐火性金属を300～4000ほど蒸着して第3金属膜を形成した後、前記第3金属膜を3次写真蝕刻してTFT部にソース電極41a及びドレイン電極41bを形成し、パッド部にパッド電極41cを形成する。この際、前記3次写真蝕刻時、TFT部に形成された不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜39も一部蝕刻されて非晶質シリコン膜37の一部が露出される。

【0028】

図10は保護膜パターンを形成する段階を示す。

詳しくは、前記基板30の全面に、例えば窒化膜を使用して保護膜を形成した後、前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン43を形成する。この際、TFT部のドレイン電極41b及びパッド部のパッド電極41cの一部が露出される。そして、ゲート-パッド連結部に形成されたゲート電極、即ち第2金属膜33上に形成されていた保護膜と絶縁膜35が同時に蝕刻され前記第2金属膜33が露出される。

【0029】

図11はゲート-パッド連結部の露出された第2金属膜を蝕刻する段階を示す。

詳しくは、部材番号45にて示された部分、即ちゲート-パッド連結部に位置し、前記保護膜パターン43により露出された第2金属膜33を蝕刻して第1金属膜31を露出させる。この工程により後続工程で形成される画素電極と第2金属膜との間のコンタクト抵

10

20

30

40

50

抗を減少させうる。

【0030】

図12は画素電極を形成する段階を示す。

詳しくは、保護膜パターンが形成された基板30の全面に透明導電膜であるITOを蒸着した後、前記ITO膜を5次写真蝕刻して第1及び第2の画素電極47を形成する。これによりTFT部ではドレイン41bと第1の画素電極47が連結され、ゲート・パッド連結部のゲート電極とパッド部のパッド電極41cが第2の画素電極47を通して連結される。

【0031】

図13乃至図16は本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。部材符号FはTFT部であって図6のI-I'線の断面図であり、Gはパッド部であって図6のII-II'の断面図である。

図13はゲート電極を形成する段階を示す。

詳しくは、透明な基板50の全面にCr、Ta、Ti等の耐火性金属を300~400ほどの厚さで蒸着して第1金属膜51を形成した後、アルミニウムまたはアルミニウム合金を1000~4000ほどの厚さで蒸着して第2金属膜53を形成する。その後、前記第2金属膜53及び前記第1金属膜51を1次写真蝕刻してTFT部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドを形成する。

【0032】

前記ゲート電極及びゲートパッドは一枚のマスクを使用して同時に形成される。前記1次写真蝕刻はまず第2金属膜53に対してテープ蝕刻を行い、引き続き第1金属膜51に対して蝕刻を行う。よって、第1金属膜51の幅が第2金属膜53の幅より広く形成される。

図14は半導体膜パターンを形成する段階を示す。

【0033】

詳しくは、ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板50の全面に絶縁膜55及び半導体膜を形成した後、前記半導体膜を2次写真蝕刻してTFT部に活性領域にて使用される半導体膜パターン57を形成する。この際、前記絶縁膜55は窒化膜(SiNx)の単一膜または窒化膜(SiNx)及び酸化膜(SiOx)の二重膜を使用して2000~9000の厚さで形成し、前記半導体膜パターン57は非晶質シリコン膜と不純物がドーピングされた非晶質シリコンを連続に蒸着して形成することができる。

【0034】

図15はソース電極及びドレイン電極を形成する段階を示す。

詳しくは、半導体膜パターン57が形成された前記基板50の全面にCr、TiまたはMoのような耐火性金属を300~4000の厚さで蒸着して第3金属膜を形成した後、前記第3金属膜を3次写真蝕刻してTFT部にソース電極61a及びドレイン電極61bを形成する。

【0035】

図16は保護膜パターン及び画素電極を形成する段階を示す。

詳しくは、ソース電極及びドレイン電極が形成された前記基板の全面に、例えば窒化膜を蒸着して保護膜を形成した後、前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン63を形成する。前記4次写真蝕刻時、TFT部のドレイン電極61bの一部が露出され、パッド部ではゲートパッド上部の絶縁膜と保護膜が同時に蝕刻されゲートパッドの一部が露出される。

【0036】

次いで、保護膜パターンにより露出された部分の第2金属膜53を蝕刻して第1金属膜51を露出させる。このように第2金属膜53を蝕刻することにより後続工程で形成される画素電極と第2金属膜との接触抵抗を減らすことができる。

その後、ITO膜を蒸着し5次写真蝕刻してTFT部のドレイン電極61bと接続される第1の画素電極65と、パッド部の第1金属膜と接続される第2の画素電極65を形成

10

20

30

40

50

する。

【0037】

前述したように、本発明の液晶表示装置の製造方法は二重ゲート電極を使用すると共に少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し、製造収率を向上させうる。

【0038】

また、ゲート電極として耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより、耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。

また、図16に示されたように、パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより、後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすことができる。

【0039】

本発明は前記実施例に限定されなく、本発明の技術的思想内で当分野の通常の知識を有する者により多くの変形が可能であることは明白である。

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図1】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図2】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図3】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

20

【図4】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図5】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図6】本発明による液晶表示装置を製造するための概略レイアウト図である。

【図7】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図8】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図9】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図10】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

30

【図11】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図12】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図13】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図14】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図15】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

40

【図16】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【符号の説明】

【0041】

30 基板

31 第1金属膜

33 第2金属膜

35 絶縁膜

37 非晶質シリコン膜

50

3 9 ドーピングされた非晶質シリコン膜

4 1 a ソース電極

4 1 b ドレイン電極

4 1 c パッド電極

4 3 保護膜パターン

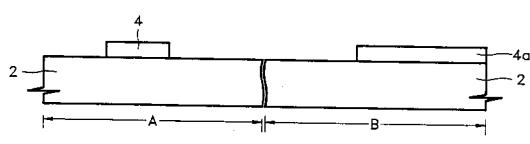
4 7 画素電極

C TFT部

D ゲート - パッド連結部

E パッド部

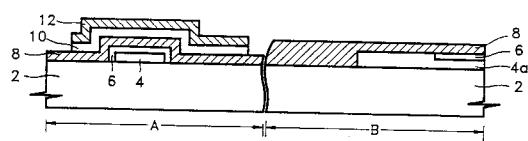
【図1】



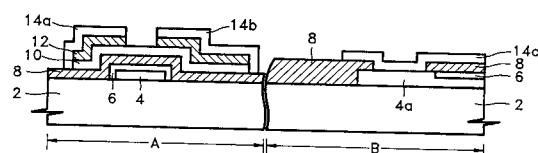
【図2】



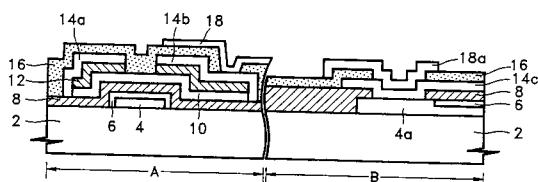
【図3】



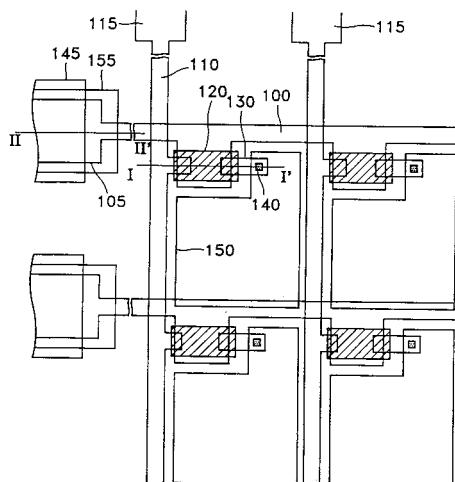
【図4】



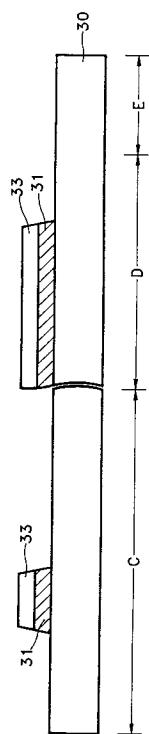
【図5】



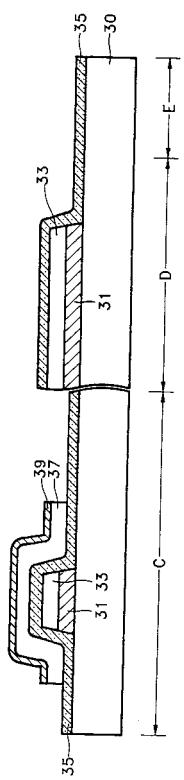
【図6】



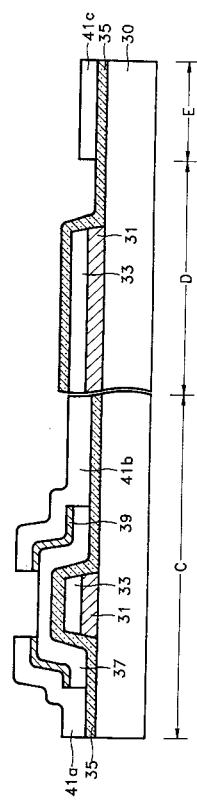
【図7】



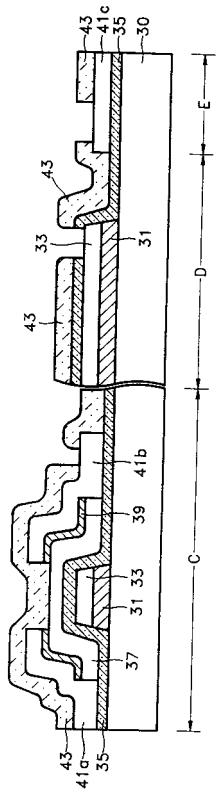
【図8】



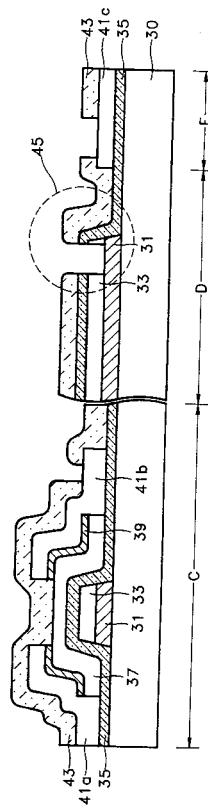
【図9】



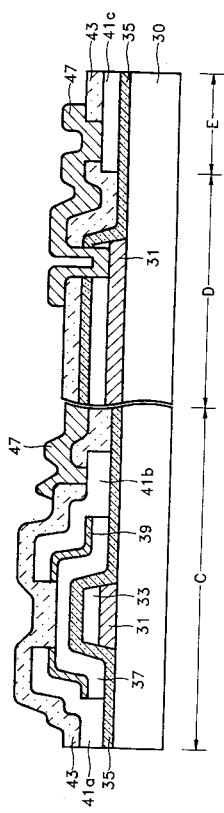
【図10】



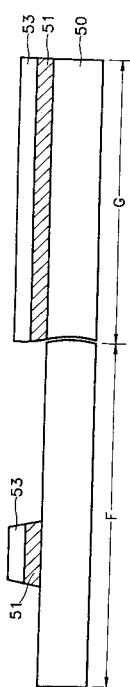
【図11】



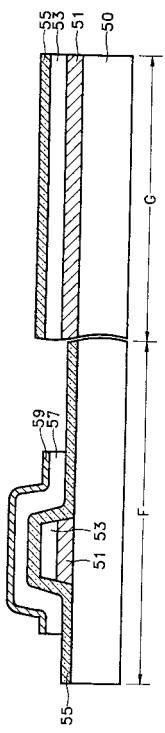
【図12】



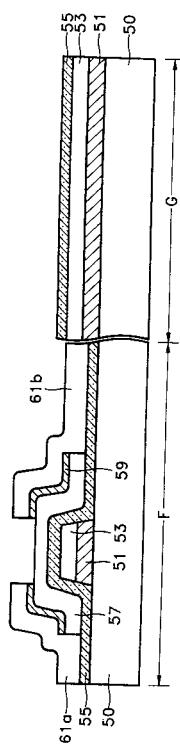
【図13】



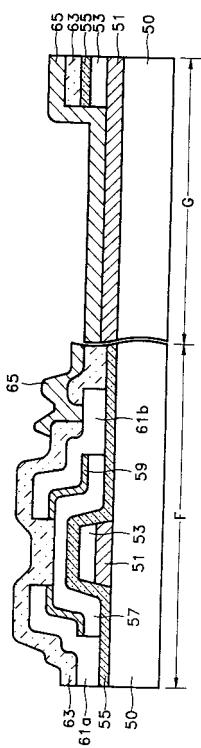
【図14】



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I
H 01 L 23/52 (2006.01)	H 01 L 21/90 A
H 01 L 21/768 (2006.01)	H 01 L 29/58 G
H 01 L 29/423 (2006.01)	H 01 L 29/78 6 1 2 D
H 01 L 29/49 (2006.01)	H 01 L 29/78 6 1 7 L
H 01 L 21/336 (2006.01)	H 01 L 29/78 6 1 7 U
H 01 L 29/786 (2006.01)	H 01 L 29/78 6 2 7 C

- (56)参考文献 特開平7 - 263700 (JP, A)
特開平6 - 230428 (JP, A)
特開平4 - 20930 (JP, A)
特開平6 - 281954 (JP, A)
特開平3 - 274029 (JP, A)
特開平6 - 138487 (JP, A)
特開平7 - 169967 (JP, A)
特開平5 - 165056 (JP, A)
特開平4 - 335617 (JP, A)
特開平5 - 142570 (JP, A)
特開平6 - 337437 (JP, A)
特開昭62 - 66665 (JP, A)
特開平7 - 234421 (JP, A)
特開平4 - 20935 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F1/1368

专利名称(译)	制造液晶显示装置的方法和TFT基板		
公开(公告)号	JP3891988B2	公开(公告)日	2007-03-14
申请号	JP2004000532	申请日	2004-01-05
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
[标]发明人	權寧贊		
发明人	權寧贊		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1345 H01L21/28 H01L21/3205 H01L23/52 H01L21/768 H01L29/423 H01L29/49 H01L21/336 H01L29/786 G02F1/1333 G02F1/136 G02F1/1362 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12		
CPC分类号	G02F1/13458 G02F1/1345 G02F1/1362 H01L27/12 H01L27/124 H01L27/1288 H01L29/4908 H01L29/66765		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1345 H01L21/28.301.R H01L21/88.R H01L21/90.A H01L29/58.G H01L29/78.612.D H01L29/78.617.L H01L29/78.617.U H01L29/78.627.C		
F-TERM分类号	2H092/GA29 2H092/GA34 2H092/GA42 2H092/HA12 2H092/HA19 2H092/JA26 2H092/JA33 2H092/JA35 2H092/JA39 2H092/JA40 2H092/JA46 2H092/JB56 2H092/JB57 2H092/KA05 2H092/KA10 2H092/KA12 2H092/KA13 2H092/KA17 2H092/KA18 2H092/KB13 2H092/MA04 2H092/MA13 2H092/MA17 2H092/MA27 2H092/NA27 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB56 2H192/CB83 2H192/CC02 2H192/CC12 2H192/CC32 2H192/FA65 2H192/HA47 2H192/HA62 4M104/AA09 4M104/BB02 4M104/BB13 4M104/BB14 4M104/BB16 4M104/BB17 4M104/BB36 4M104/CC05 4M104/DD07 4M104/FF08 4M104/FF13 4M104/FF09 4M104/GG09 4M104/GG10 4M104/GG14 4M104/HH03 4M104/HH15 5F033 /GG04 5F033/HH38 5F033/JJ38 5F033/KK08 5F033/KK10 5F033/KK17 5F033/KK18 5F033/KK20 5F033/KK21 5F033/MM05 5F033>NN13 5F033>NN17 5F033/QQ08 5F033/QQ09 5F033/QQ37 5F033 /RR06 5F033/VV07 5F033/VV15 5F033/XX09 5F033/XX16 5F033/XX33 5F110/AA16 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/EE03 5F110/EE04 5F110/EE06 5F110/EE14 5F110/EE23 5F110/EE37 5F110 /FF02 5F110/FF03 5F110/FF09 5F110/FF27 5F110/GG02 5F110/GG15 5F110/GG25 5F110/HK04 5F110/HK09 5F110/HK16 5F110/HK21 5F110/HK32 5F110/HL07 5F110/NN02 5F110/QQ01		
助理审查员(译)	井上博之		
优先权	1995P62170 1995-12-28 KR 1996P18516 1996-05-29 KR		
其他公开文献	JP2004157555A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种制造液晶显示器的方法，以减少光刻工艺的数量。ŽSOLUTION：液晶显示器按以下步骤制造。它们是：栅电极和栅极焊盘，包括由难熔金属制成的第一金属膜层和由Al制成的第二金属膜，通过第一光刻工艺形成；在基板的整个面上形成绝缘膜；通过第二光刻工艺在TFT部分中的绝缘膜上形成半导体膜图案；通过第三光刻工艺在TFT部分中形成包括第三金属膜的源电极和漏电极。此外，制造液晶显示器的方法包括以下步骤：在基板的整个面上形成保护膜之后，对保护膜和绝缘膜进行第四光刻工艺以形成暴露的保护膜图案。TFT部分中的漏电极和焊盘部分中的栅极焊盘；通过使用保护膜图案作为掩模来蚀刻第二金属膜，以暴露焊盘部分中的第一金属膜；通过第五光刻工艺形成与TFT部分的漏电极接触的第一像素电极图案和与焊盘部分中的第一金属膜接触的第二像素电极图案。Ž

【図5】

